

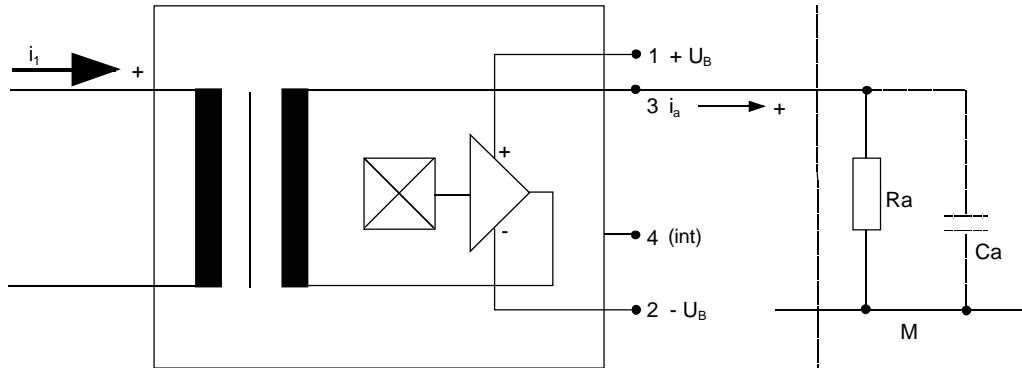
K-Nr.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: 24.05.2002
K-no.:		Date:
Kunde: Typenelement/Standard type	Kd. Sach Nr.:	Seite 1 von 6
Customer	Customers part no.:	Page of

Maßbild siehe Blatt 2 :

Mechanical outlines page 2

Anschlußschema:

Schematic diagram


Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

Operational data/characteristic data (nominal values):

Nennstrom Rated current	i_{1Neff}	=	200	A
Nennausgangsstrom Output current	i_{aNeff}	=	100	mA
Nennübersetzungsverhältnis Transformation ratio	K_N	=	(1) : 2000	
Überstrom ($R_a < 25 \Omega$) Over current ($R_a < 25 \Omega$)	i_{max}	=	± 400	A
Versorgungsstrom im Leerlauf Supply current	I_{Bo}	=	14	mA
Versorgungsspannung Supply voltage	U_B	=	± 15	V $\pm 5\%$
Maximale Versorgungsspannung (ohne Fkt.) Maximum supply voltage (without function)	U_{Btot}	=	± 18	V
Innenwiderstand Internal resistance	R_i	<	29	Ω
Abschlußwiderstandsbereich Load resistance	R_a	=	20...200	Ω
Umgebungstemperatur Ambient temperature	T_U	=	-40...+70	$^{\circ}C$
	T_U	=	-40...+85	$^{\circ}C$
			für $R_a \geq 50 \Omega$ for $R_a \geq 50 \Omega$	

Weitere Vorschriften: Gehäuse- und Spulenkörperwerkstoff UL-gelistet.

Housing and bobbin material UL-listed

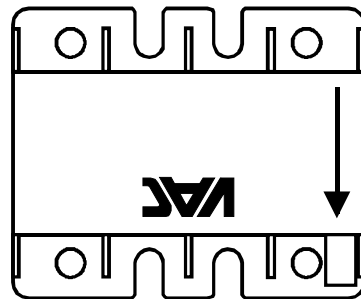
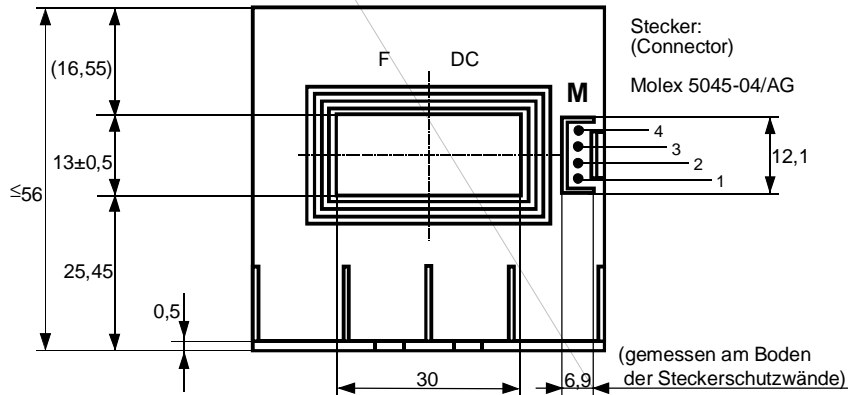
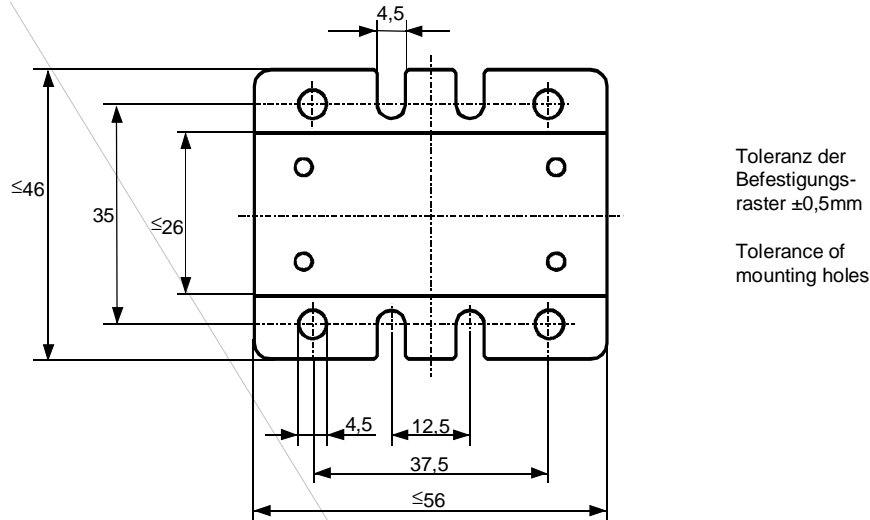
Applicable documents:

Datum	Name	Index	Änderung
24.05.02	HH.	82	Maßbild aktualisiert.

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb.: Le.		KB-PM B:Gör.		freig.: HH.
-----------------	-------------	--	--------------	--	-------------

K-Nr.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum:	24.05.2002
K-no.:		Date:	
Kunde:	Typenelement/Standard type	Kd. Sach Nr.:	Seite 2 von 6 Page of
Customer		Customers part no.:	

Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General tolerances



DC=Date Code
 F=Factory

Optimale Position des Rückleiters für kurze Ansprechzeiten ist eine seitliche Rückführung des Primärleiters in Höhe des Innenlochs.

Optimal position of the return conductor for short response time is alongside at the same height as the inner hole.

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb.: Le.	KB-PM B:Gör.	freig.: HH.
-----------------	-------------	--------------	-------------

K-Nr.: K-no.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: 24.05.2002 Date:
Kunde: Typenelement/Standard type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 3 von 6 Page of

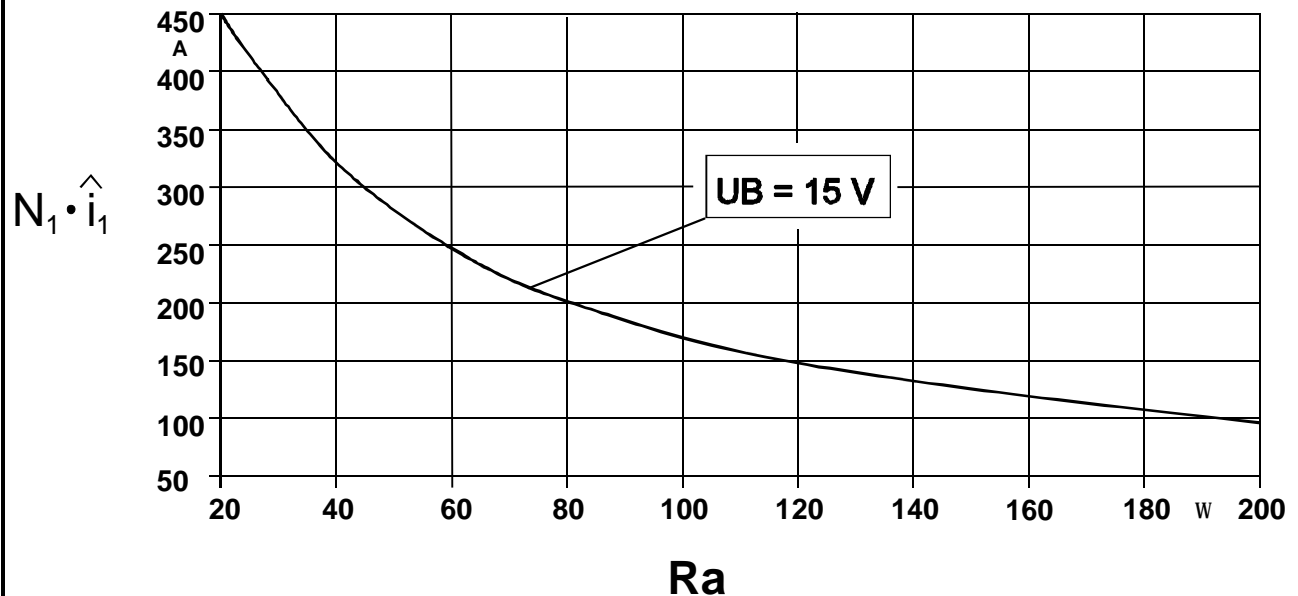
Prüfung: (V:100%-Test; AQL...:DIN ISO 2859-Teil 1)

Inspection

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1) | (V) | Ausgangsstrom ($R_a = 20 \Omega$)
Output current ($R_a = 20 \Omega$) | $i_a (200 A) = 100 \text{ mA} \pm 0,5 \%$ |
| 2) | (V) | Offsetstrom
Offset current | $I_o \leq 0,05 \text{ mA}$ |
| 3) | (V) | M3014: Prüfspannung (50 Hz, 2 s)
Test voltage (50 Hz, 2 s) | $U_{p,eff} = 6 \text{ kV}$
C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4
C_u -bar in the center hole to Pin1...Pin4 |
| 4) | (AQL 1/S4) | M3024: Glimmaussetzspannung
Partial discharge | $U_{TA,eff} \geq 1770 \text{ V}$
C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4
C_u -bar in the center hole to Pin1...Pin4 |

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Measurements after temperature balance of the samples at room temperature





DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60404-N4644-X051

Item no.:

K-Nr.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: 24.05.2002
K-no.:		Date:
Kunde: Typenelement/Standard type	Kd. Sach Nr.:	Seite 4 von 6
Customer	Customers part no.:	Page of

Charakteristische Daten (Richtwerte) des Stromsensormoduls ermittelt durch eine Typprüfung			
General data ascertained by type test			
Meßgenauigkeit bei Raumtemperatur Measuring accuracy at room temperature	F_i	<	0,5 %
Linearität Linearity	F_{Li}	<	0,2 %
Temperaturdrift von F_i (-40...+70°C) Temperature drift of F_i (-40...+70°C)	F_{Ti}	<	0,1 %
Frequenzbereich (bei eingeschränkter Amplitude) Frequency range (with limited amplitude)	f	=	DC...50** kHz
Ansprechzeit Response time	τ	<	5** μ s
Verzögerungszeit bei \hat{i}_{1max} bei einem Stromanstieg von $di/dt = 100 A/\mu s$ Δt (i_{1max} , 100 A/ μ s) Delay time at \hat{i}_{1max} with a current rise of $di/dt = 100 A/\mu s$		<	3** μ s
Offsetstrom (beinhaltend I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT}) Offset current (including I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT})	I_{oges}	<	0,1 mA
Offsetstrom bei Raumtemperatur Offset current at room temperature	I_o	<	0,05 mA
Drift von I_o Offset current drift	ΔI_{ot}	<	0,05 mA
Temperaturdrift von I_o (-40...+70°C) Offset current temperature drift (-40...+70°C)	ΔI_{oT}	<	0,05 mA
Hysterese von I_o Hysteresis of I_o	ΔI_{oH}	<	0,12 mA
Offsetripple (s.Blatt 5) Offset ripple (s. page 5)	i_{oss}	<	2 mA
Versorgungsspannungsdurchgriff auf I_o Supply voltage rejection ratio	$\Delta I_o/\Delta U_B$	<	0,01 mA/V
Koppelkapazität primär - sekundär Coupling capacitance (primary - secondary)	C_k	<	15 pF
Ausgangsstörgleichstrom Interference output current	I_{aSt}	<	0,1 mA
Kritischer Abstand bei einem Störimpuls Critical distance with an interference pulse current	a_{Krit}	<	9 cm
Spannungsfestigkeit (gültig nach DIN VDE 0160, für Isolierklasse I, Verschmutzungsgrad 2 und verstärkte Isolierung)			
Dielectric strength (with DIN VDE 0160: material group I, pollution degree 2, reinforced insulation)			
Prüfspannung (50 Hz, 1 min) Test voltage (50 Hz, 1 min)	$U_{p,eff}^*$	=	5 kV
Bemessungsspannung für Kriechstrecke (DIN VDE 0160) Working voltage (DIN VDE 0160)	$U_{is,eff}^*$	≤	2000 V
Bemessungsspannung für Luftstrecke (DIN VDE 0160) Working voltage (DIN VDE 0160)	\hat{U}_{is}^*	≤	2000 V
Netz- Nennspannung gegen Erde für Luftstrecke (DIN VDE 0160) Rated mains voltage vs. earth (DIN VDE 0160)	$U_{N,eff}^*$	≤	690 V
Anwendungsklasse nach DIN 40040 Feuchtklasse E erfüllt (Applicability tested by IEC 68-2-30: test Db)			
Lagertemperaturbereich Storage temperature range	T_L	=	-40 ... +85°C
Masse Masse	m	<	125 g
Stromrichtung: Ein positiver Meßstrom erscheint am Anschluß i_a , wenn der Primärstrom in Pfeilrichtung fließt. Current direction: A positiv output current appears at point i_a by primary current in direction of the arrow.			
*Die Spannungsfestigkeit gilt am separaten Bauelement zwischen Primärleiter und den Stiften 1...4. The dielectric strength is valid between primary conductor and pin 1...4.			
** Bei seitlicher Rückführung des Primärleiters in Höhe des Innenlochs. With return conductor alongside at the same height as the inner hole.			

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb: Le.	KB-PM B:Gör.	freig.: HH.
-----------------	------------	--------------	-------------

K-Nr.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: 24.05.2002
K-no.:		Date:
Kunde: Typenelement/Standard type	Kd. Sach Nr.:	Seite 5 von 6
Customer	Customers part no.:	Page of

Mögliche Offsetripple-Verringerung durch Tiefpaß:

Variable offset ripple reduction means of a low pass:

Der Offsetripple kann durch einen externen Tiefpaß verringert werden. Dazu muß parallel zu R_a eine Kapazität C_a geschaltet werden. Die Abbildung zeigt den verbleibenden Wert des Offsetripples ($i_{oss}(R_a \cdot C_a)$) bezogen auf den Wert ohne externe Kapazität (i_{oss}). Hierbei wird allerdings die Ansprechzeit verlängert. Sie berechnet sich nach der Formel:

The offset ripple can be reduced by an external low pass. Therefore a capacitance C_a must be switched parallel to R_a . The diagram shows the remaining value of the offset ripple ($i_{oss}(R_a \cdot C_a)$) relative to the value without external capacitance (i_{oss}). In this case the response time is lengthened. It is calculated from:

$$\tau_a \leq \tau + 2,5 \cdot R_a \cdot C_a \quad \text{bzw.} \quad f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_a \cdot C_a}$$

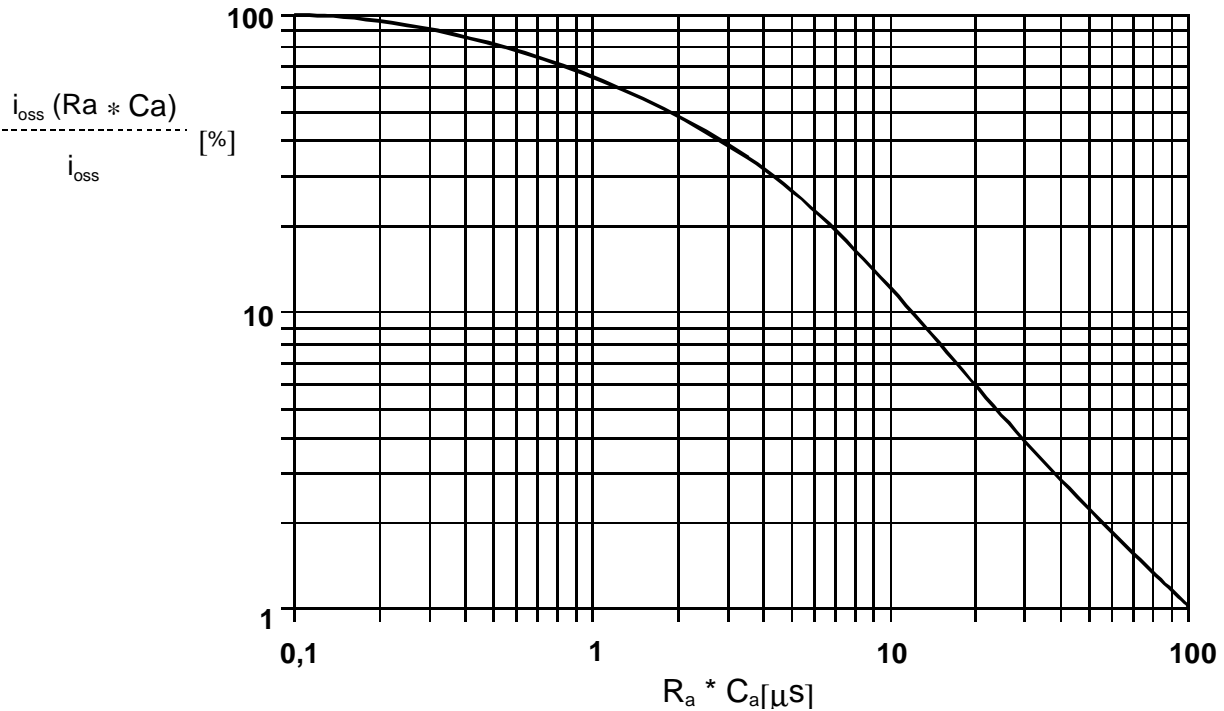
Beispiel:

$$\frac{i_{oss}(R_a \cdot C_a)}{i_{oss}} = 25\%$$

Example:

$$R_a = 47 \Omega; \quad C_a = 100 \text{ nF}$$

$$\tau_a \leq 21 \mu\text{s}; \quad f_g = 34 \text{ kHz}$$





K-Nr.:	200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: 24.05.2002
K-no.:		Date:
Kunde: Typenelement/Standard type	Kd. Sach Nr.:	Seite 6 von 6
Customer	Customers part no.:	Page of

Erläuterung einiger in den Tabellen verwendeter Größen (alphabetisch)

Explanation of several of the terms used in the tablets (in alphabetical order)

a_Krit: Abstand eines störstromführenden Leiters von der Gehäuseseitenfläche, bei dem auch an ungünstiger Stelle die zugeordnete Störgröße am Ausgang des Sensos 1% des Nennstroms nicht übersteigt. Den Angaben liegt ein sinusförmiger Störimpuls mit einer Impulsweite von 50 µs in Höhe des Nennstroms zugrunde.

Distance of a current carrying conductor from the sides of the housing, where even at the most unfavourable spot the applicable interference at the sensor output does not exceed 1% of rated current. The data is based on a sinusoidal interference pulse current with a pulse width of 50 µs having the same magnitude as the rated current.

F_ges(i_1): Die Summe aller möglichen Fehler im gesamten Temperaturbereich bei der Messung eines Stroms i_1:

The sum of all possible errors over the temperature range when measuring a current i_1:

F_ges = 100 * | (i_a(i_1) / (K_N * i_1)) - 1 |

F_i: In der Ausgangsprüfung zugelassener Meßfehler bei RT, definiert durch

Permissible measurement error in the final inspection at RT, defined by

F_i = 100 * | (I_a / I_aNeff) - 1 |

wobei I_an der offsetbereinigte Ausgangsgleichstromwert für einen Eingangsgleichstrom in Höhe des (positiven) Nennstroms ist (d.h. I_o = 0)

where I_an is the output DC value of an input DC current of the same magnitude as the (positive) rated current (I_o = 0)

F_Li: Linearitätsfehler definiert durch F_Li = 100 * | (I_1 / I_1Neff) - (I_a / I_an) |

Dabei ist I_1 beliebiger Eingangsgleichstrom und I_a die zugehörige offsetbereinigte Ausgangsgröße (d.h. I_o = 0). I_an s. Erläuterung zu F_i.

Where I_1 is any input DC and I_a the corresponding output term. I_an see notes of F_i (I_o = 0).

F_Ti: Temperaturdrift der nennwertbezogene Ausgangsgrößen I_an (vgl. Erläuterung zu F_i) im spezifischen Temperaturbereich, gegeben durch.

Temperature drift of the rated value orientated output term. I_an (cf. Notes on F_i) in a specified temperature range, obtained by:

F_Ti = 100 * | (I_an(T_U2) - I_an(T_U1)) / I_aNeff |

I_aSt: Ausgangsgleichstrom hervorgerufen durch einen Störgleichstrom in Höhe des Nennstroms in einem Leiter in 1 cm Abstand von der Gehäuseseitenfläche (ungünstige Lage).

Output DC current caused by an interfering DC current of the same magnitude as the rated current in a conductor 1 cm away from the sides of the housing (unfavourable position).

Delta I_oH: Nullpunktabweichung nach Übersteuerung mit Gleichstrom des 4-fachen Nennwerts. (R_a = R_aN)

Zero variaton after overloading with a DC of fourfold the rated value. (R_a = R_aN)

Delta I_ot: Langzeitdrift von I_o nach 100 Temperaturwechseln im Bereich von -40 bis 85 °C.

Long term drift of I_o after 100 temperature cycles in the range -40 to 85 °C.

tau: Ansprechzeit, gemessen als Verzögerungszeit bei i_1 = 0,9 * I_1 zwischen einem eingespeisten Rechteckstrom und dem dazugehörigen Ausgangsstrom.

Response time, measured as delay time at i_1 = 0,9 * I_1 between a rectangular current i_1 and the output current i_a

Delta t (I_1max, 100 A/µs): Verzögerungszeit zwischen I_1max und dem dazugehörigen Ausgangsstrom i_a bei einem Stromanstieg des Primärstroms von di_1/dt = 100 A/µs.

Delay time between I_1max and the output current i_a with a primary current rise of di_1/dt = 100 A/µs.

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb: Le.		KB-PM B:Gör.		freig.: HH.
-----------------	------------	--	--------------	--	-------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60404-N4644-X051](#)